

	Si-SiC
Max. Teplota použití (°C)	1380
Chemické složení (%)	
SiC	90
Si	10
Si ₃ N ₄	0
SiO ₂	0
Porosita (%)	<0.1
Hustota (g/cm ³)	>3.02
Odolnost vůči křehkému lomu (Modulus of Rupture) (MPa)	
Za pokojové teploty	250
Za 1200°C	250
Za 1400°C	
Teplotní roztažnost za 1000°C (K ⁻¹)	4.5*10 ⁻⁶
Tepelná vodivost za 1000°C (W/m.K)	40